ปารีณา พันธรักษ์ : การศึกษากลใกการกระจายของอัตราการ โตของผลึก (A STUDY INTO THE MECHANISM OF CRYSTAL GROWTH RATE DISPERSION) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.เอเครียน ฟลัค, 122 หน้า. ISBN 974-533-342-5

การกระจายของอัตราการ โตของผลึก/ จือาร์ดี/ ความขรุขระของผิวผลึก

จุดมุ่งหมายหลักของวิทยานิพนธ์นี้คือเพื่อเข้าใจในปรากฏการณ์การกระจายของอัตราการโต ของผลึก (จือาร์ดี)ให้ดีขึ้น ซึ่งแสดงถึงผลึกที่มีลักษณะเหมือนกันและอยู่ในสภาวะเงื่อนไขเดียวกัน แต่ กลับโตด้วยอัตราการโตที่แตกต่างกัน วิทยานิพนธ์นี้ได้ทำการศึกษาว่า (ก) กลไกการโตใดที่เป็นสาเหตุ ให้มีการกระจายตัวของอัตราการโตของผลึก (การแพร่ผ่าน และ/หรือการรวมตัวของผิว) (ข) สาเหตุ ของแต่ละกลไกที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของอัตราการโตของผลึก และ (ค) เครื่องตกผลึกที่ประดิษฐ์ ใช้ในการทดลองมีผลกระทบต่อการวัดอัตราการกระจายตัวของผลึกในการวิจัยทั่วไปหรือไม่

การศึกษาอัตราการ โตและอัตราการละลายของผลึกน้ำตาลภายใต้สภาวะหยุดนิ่ง และสภาวะที่มี การใหลเวียนในเครื่องตกผลึกสามชนิด ได้แก่ เครื่องตกผลึกขนาดเล็ก เครื่องตกผลึกแบบท่อ และเครื่อง ตกผลึกขนาด 2 ลิตร ให้ผลแสดงว่า สิ่งประดิษฐ์ของเครื่องตกผลึกขนาดเล็กทำให้เกิดจือาร์ดีสูงกว่า เครื่องตกผลึกอีกสองชนิดประมาณ 1.2-1.5 เท่าภายใต้สภาวะที่มีการ ใหลเวียน ผลที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ คือ ในเครื่องตกผลึกขนาดเล็กภายใต้สภาวะที่มีการ ใหลเวียน ผลึกต่างกันจะประสบกับสภาวะการ ใหล เวียนของสารละลายต่างกัน

จากการศึกษาพบว่ามีผลที่แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สำหรับการกระจายตัวของอัตราการโตทั้งในขั้นตอนการแพร่ผ่านและการรวมตัวของผิว ผลศึกษานี้ได้มาจากการศึกษาอัตราการโตและ อัตราการละลายของผลึกน้ำตาลและผลึกเฮกซะเมทิสินเตตระมีน หรือ ผลึกเอ็ชเอ็มที่ ในสภาวะหยุดนิ่ง การโตของผลึกเอ็ชเอ็มที่ถูกควบคุมด้วยกลไกการแพร่ผ่าน ในขณะที่การโตของผลึกน้ำตาลบางส่วนถูก ควบคุมด้วยกลไกการรวมตัวของผิว ในที่ที่มีอัตราการไหลเวียนสูง การโตของผลึกทั้งน้ำตาลและ เอ็ช เอ็มที่ถูกควบคุมด้วยกลไกการรวมตัวของผิว ทั้งผลึกน้ำตาลและผลึกเอ็ชเอ็มที่ แสดงการกระจายตัวของ อัตราการโต และอัตราการละลายของผลึกอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้สภาวะหยุดนิ่งและสภาวะที่มีการไหล เวียน ซึ่งแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงการกระจายตัวของอัตราการโตในทั้งกลไกการแพร่ผ่าน และกลไกการ รวมตัวของผิว

การกระจายตัวของอัตราการ โตของกล ใกการแพร่ผ่าน เกิดจากความแตกต่างของตำแหน่งของ ผลึกที่สัมพันธ์กับการ ใหลเวียนของสาร ซึ่งผลดังกล่าวมีนัยสำคัญมากในระบบที่ผลึกมีการกำหนด ตำแหน่งของผลึก และจะมีความเป็นนัยสำคัญน้อยในเครื่องตกผลึกแบบแขวนลอย ที่ซึ่งผลึกมีการ แปลี่ยนตำแหน่งในระบบอย่างต่อเนื่อง

การกระจายตัวของอัตราการ โตของกลไกการรวมตัวของผิว เกิดจากความแตกต่างในโครงสร้าง ผิวของผลึกที่ต่างกันในระบบ โครงสร้างผิวของผลึก โดยเฉพาะความขรุขระผิวที่เห็นชัดในระดับมอง ด้วยกล้องจุลทรรศน์มีความสัมพันธ์กับประวัติการ โตของผลึก โดยที่ผลึกที่ โตในสารละลายอิ่มตัวยิ่ง ยวดมากกว่าจะมีความขรุขระของผิวกว่าผลึกที่ โตในสภาวะที่สารละลายมีความอิ่มตัวยิ่งยวดน้อยกว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดในสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดที่มีระดับมากกว่าระดับวิกฤต ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึง ภาวะการเปลี่ยนแปลงลำดับความขรุขระผิว ภาวะการเปลี่ยนแปลงลำดับความขรุขระผิว พล้งงานเชิงผิวสูงกว่าจะมีค่าภาวะการเปลี่ยนแปลงลำดับความ ขรุขระผิวต่ำกว่า

สาขาวิชา<u>วิศวกรรมเคมี</u> ปีการศึกษา 2547 ลายมือชื่อนักศึกษา ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา_____ PAREENA PANTARAKS: A STUDY INTO THE MECHANISM OF CRYSTAL GROWTH RATE DISPERSION. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. ADRIAN FLOOD, Ph.D. 122 PP. ISBN 974-533-342-5

GROWTH RATE DISPERSION/ GRD/ SURFACE ROUGHNESS

The major aim of this work is to obtain the better understanding of growth rate dispersion (GRD), whereby seemingly identical crystals grow at different rates under identical conditions. The study investigated; (a) which growth mechanisms (diffusion and/or surface integration) are responsible for GRD; (b) the causes of GRD in each mechanism; and (c) whether experimental artifacts affect measurements of GRD in common research crystallization units.

Investigation of growth and dissolution rates of sucrose crystals under stagnant and convection conditions in three types of crystallizer including the small-cell, the pipe-cell, and the 2-L batch crystallizers showed that an artifact of the small-cell crystallizer appeared to generate GRD of 1.2-1.5 times higher magnitude than the other two crystallizers under convection conditions. The reason for the artifact is that in the small cell crystallizer, under convection conditions, different crystals experience different hydrodynamic conditions in the cell.

It has been shown that there is potential for rate dispersion in both the diffusion step and the integration step of crystal growth. This was determined by studying the crystal growth and dissolution rates of sucrose and hexamethylene tetramine (HMT) crystals. In stagnant conditions the crystal growth of HMT is mass transfer controlled, whilst the crystal growth of sucrose is partly controlled by the surface integration step. At very high solution flow the growth of both types of crystal

IV

is surface integration rate controlled. Both sucrose and HMT displayed significant

growth rate and dissolution rate dispersion, both in stagnant and flow conditions, and

thus dispersion in rate in both mechanisms is evident.

The dispersion in the rates of diffusion in the system is due to differences in

the orientation of crystals with respect to the flow. This is most significant in systems

where the crystal has a fixed orientation, and will be far less significant in suspension

crystallizers, where crystals reorient in the suspension continuously.

The dispersion in the rates of the surface integration step is due to variations

in the surface structure of different crystals in the system. The surface structure of the

crystal, in particular the degree of surface roughness evident on a microscopic scale,

is related to the growth history of the crystal, with crystals having a history of high

growth in high supersaturation environments having a significantly rougher surface

than similar crystals with a more benign history. This phenomenon only occurs at

supersaturations higher than a critical level, which is referred to as the roughening

transition. The roughening transition is dependent on the surface energy of the

crystals, with crystals having a higher surface energy also having a lower roughening

transition.

School of <u>Chemical Engineering</u>

Student's Signature____

Academic Year 2004

Advisor's Signature